INA6012AS1

低周波電力増幅用
シリコン PNP バイポーラトランジスタ

概 要

INA6012AS1は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、高耐圧に設計、製造されております。

特 長

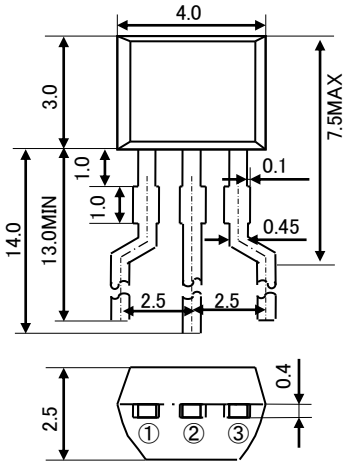
●コレクタ電流が大きい I_{Cmax}=−0.2A
●耐圧が高い V_{CEO}=−400V

用 途

DC−DC コンバータ、高電圧スイッチング

外形図

単位:mm



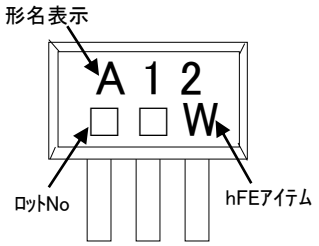
電極接続
①:エミッタ
②:コレクタ
③:ベース

JEITA:ー
JEDEC:ー

最大定格(Ta=25℃)

記 号	項 目	定 格 値	単位
V_{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	−400	V
V_{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	−7	V
V_{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	−400	V
I_C	コレクタ電流	−200	mA
I_{CM}	尖頭コレクタ電流	−500	mA
P_C	コレクタ損失(Ta=25℃)	600	mW
T_j	接合部温度	＋150	℃
T_{stg}	保存温度	−55～＋150	℃

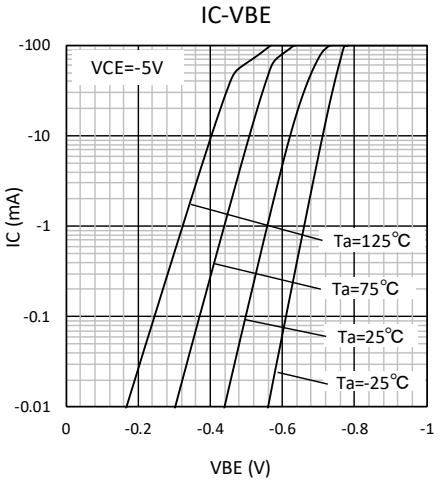
マーキング図

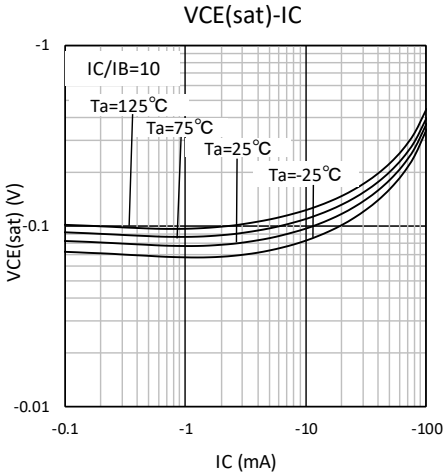


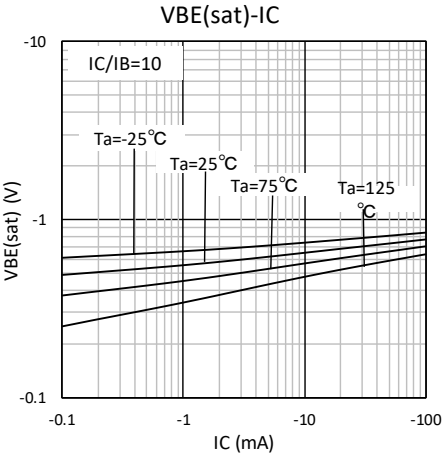
電気的特性(Ta=25℃)

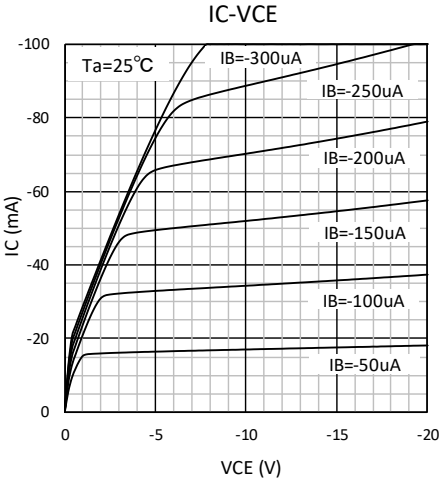
記 号	項 目	測 定 条 件	規 格 値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	I_C=−50μA, I_E=0mA	−400	−	−	V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	I_E=−50μA, I_C=0mA	−7	−	−	V
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I_C=−1mA, R_{BE}=∞	−400	−	−	V
I_{CBO}	コレクタしゃ断電流	V_{CB}=−400V, I_E=0mA	−	−	−1	μA
I_{EBO}	エミッタしゃ断電流	V_{EB}=−6V, I_C=0mA	−	−	−1	μA
h_{FE}	直流電流増幅率	V_{CE}=−5V, I_C=−100mA	140	−	−	−
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	I_C=−50mA, I_B=−5mA	−	−	−0.75	V
$V_{BE(sat)}$	ベース・エミッタ飽和電圧	I_C=−50mA, I_B=−5mA	−	−	−1.1	V
f_T	利得帯域幅積	V_{CE}=−5V, I_E=10mA	−	30	−	MHz
Cob	コレクタ出力容量	V_{CB}=−20V, I_E=0mA, f=1MHz	−	7	−	pF

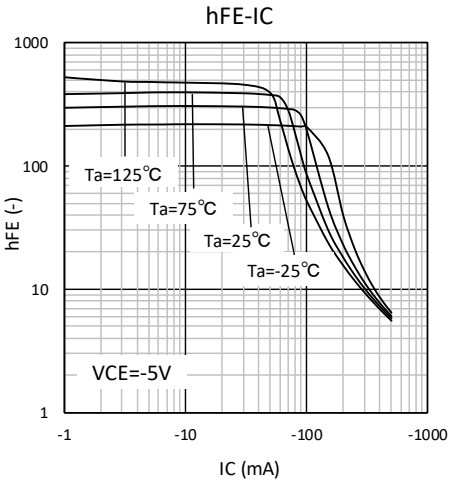
標準特性

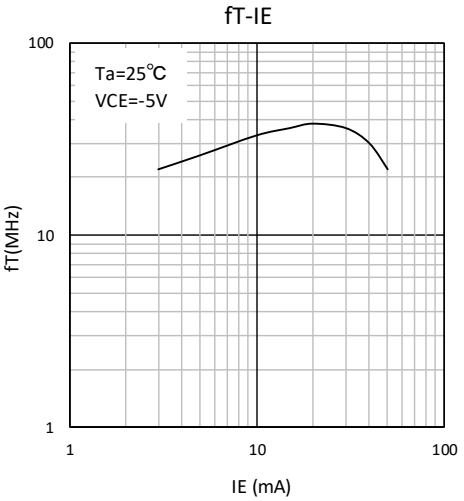

IC-VBE
VCE=-5V
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
IC (mA)
VBE (V)
-100
-10
-1
-0.1
-0.01
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

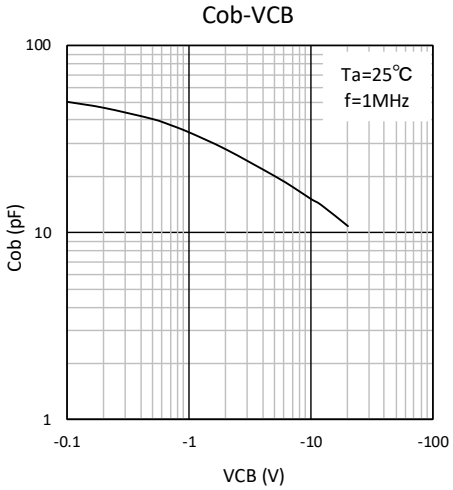

VCE(sat)-IC
IC/IB=10
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
VCE(sat) (V)
IC (mA)
-1
-0.1
-0.01
-0.1
-1
-10
-100

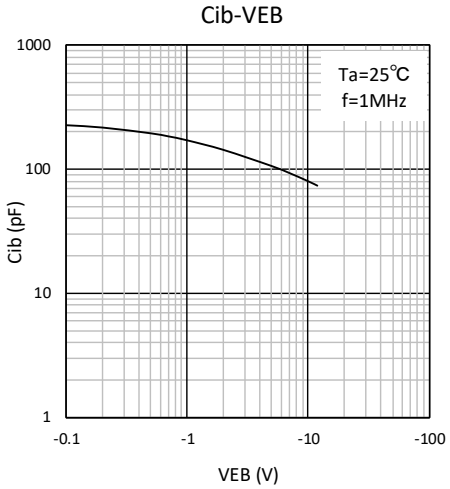

VBE(sat)-IC
IC/IB=10
Ta=-25℃
Ta=25℃
Ta=75℃
Ta=125
℃
VBE(sat) (V)
IC (mA)
-10
-1
-0.1
-0.1
-1
-10
-100

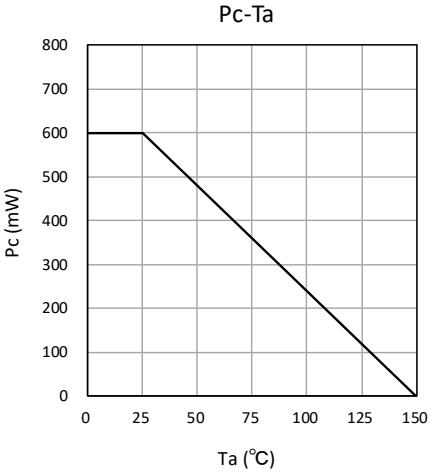

IC-VCE
Ta=25℃
IB=-300uA
IB=-250uA
IB=-200uA
IB=-150uA
IB=-100uA
IB=-50uA
IC (mA)
VCE (V)
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
-5
-10
-15
-20


hFE-IC
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
VCE=-5V
hFE (-)
IC (mA)
1000
100
10
1
-1
-10
-100
-1000


fT-IE
Ta=25℃
VCE=-5V
fT(MHz)
IE (mA)
100
10
1
1
10
100


Cob-VCB
Ta=25℃
f=1MHz
Cob (pF)
100
10
1
-0.1
-1
-10
-100
VCB (V)


Cib-VEB
Ta=25℃
f=1MHz
Cib (pF)
1000
100
10
1
-0.1
-1
-10
-100
VEB (V)


Pc-Ta
Pc (mW)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75
100
125
150
Ta (℃)

安全設計に関するお願い

・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たりましては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。

2022 年 1 月

イサハヤ電子株式会社